



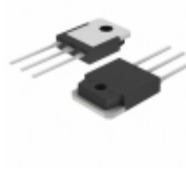




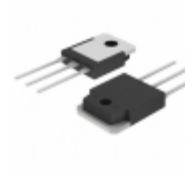
	<b>GP1M010A060H</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	GP1M010A060H
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Global Power Technologies Group
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 10A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M010A060H.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1998 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M010A060H
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1998 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	198W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1891pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M010A060H ist neu im Original, Suche GP1M010A060H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M010A060H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M010A060H: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>GP1M010A060FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220F</p>	 <p><b>GP1M011A050FSH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220F</p>	 <p><b>GP1M010A080N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 10A TO3PN</p>	 <p><b>GP1M009A090H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220</p>
 <p><b>GP1M010A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M011A050FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220F</p>	 <p><b>GP1M010A080H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220</p>	 <p><b>GP1M009A090N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN</p>

heiße Teile

Mehr

 GP1FA550RZ	 GP1FA550TZ	 GP1FA551	 GP1FA551TZ	 GP1FA553RZ0F
 GP1FA553RZ0F	 GP1FA553TZ0F	 GP1FAV31TK0F	 GP1FAV50RK0F	 GP1FAV50TK0F
 GP1FAV51TK0F	 GP1FD320TP0F	 GP1FM313TMF5	 GP1FM313TZMF	 GP1FSV51TK0F
 D GP1L53VJ000F	 GP1L57J0000F	 GP1M003A050FG	 GP1M003A080CH	 GP1M003A090C
 GP1M006A070FH	 GP1M007A090H	 GP1M008A025PG	 GP1M009A020FG	 GP1M009A090N
 GP1M010A080FH	 GP1M011A050FH	 D GP1M013A050H	 GP1M016A025CG	 GP1M016A060F
 GP1M016A060H	 D GP1S092HCPI	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPKF
 GP1S093HCZ	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 GP1S094HCZ0F
 GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZ0F	 GP1S096HCZ	 D GP1S096HCZ0F	 GP1S096HCZ0F
 GP1S097HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S195HCPS4	 GP1S195HCPSF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited